

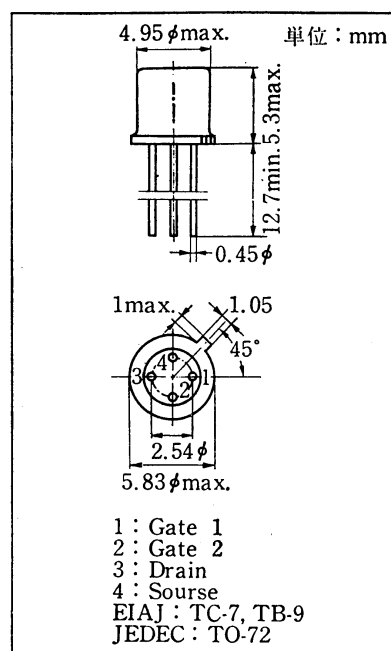
3SK32 (保守品種/MAINTENANCE)

シリコン N チャンネル MOS 型 FET/Si N-Channel MOS-FET

VHF 高周波増幅用/VHF Amplifier

最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース電圧	V _{DS}	20	V
ゲート1・ソース電圧	V _{G1S}	-10~+8	V
ゲート2・ソース電圧	V _{G2S}	-10~+8	V
ドレイン電流	I _D	15	mA
許容損失	P _T	170	mW
チャンネル部温度	T _{ch}	125	°C
保存温度	T _{stg}	-65~+150	°C



電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項目	記号	条件	min.	typ.	max.	単位
ドレイン電流	I _{DSS}	V _{DS} =10V, V _{G1S} =0, V _{G2S} =5V	0		5	mA
ゲート1・カットオフ電圧	V _{G1S(off)}	V _{DS} =10V, I _D =50μA, V _{G2S} =5V	0		-2.5	V
ゲート2・カットオフ電圧	V _{G2S(off)}	V _{DS} =10V, I _D =50μA, V _{G1S} =0	0		-2.5	V
ゲート1・漏えい電流	I _{G1SS}	V _{G1S} =10V, V _{DS} =V _{G2S} =0			100	pA
ゲート2・漏えい電流	I _{G2SS}	V _{G2S} =10V, V _{DS} =V _{G1S} =0			100	pA
順伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} =10V, I _D =5mA, V _{G2S} =5V, f=455kHz	5		10	mΩ
電力利得	G _{PS}	V _{DS} =10V, I _D =8mA, V _{G2S} =5V, f=200MHz, BW=4MHz	15		25	dB
入力容量	C _{iss}	V _{G1S} =10V, V _{DS} =V _{G2S} =0, f=455kHz		5		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} =10V, V _{G1S} =V _{G2S} =-10V, f=455kHz		35		mpF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} =10V, V _{G1S} =V _{G2S} =-10V, f=455kHz		3		pF

I_{DSS}, G_{PS} により下表のように分類し、現品表示しています。

G _{PS} (dB)	15~22		19~25	
	0~3	2~5	0~3	2~5
I _{DSS} (mA)				
分類	A	B	C	D